

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2003221274  
PUBLICATION DATE : 05-08-03

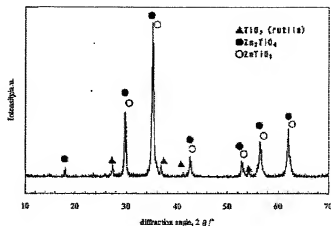
APPLICATION DATE : 12-04-02  
APPLICATION NUMBER : 2002110518

APPLICANT : UBE IND LTD;

INVENTOR : FUKUDA KOICHI;

INT.CL. : C04B 35/46 C04B 35/495 H01B 3/12  
H01G 4/12

TITLE : DIELECTRIC PORCELAIN  
COMPOSITION AND INTEGRATED  
CERAMIC PARTS USING IT



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dielectric porcelain composition which can be baked at a temperature of 800-1,000°C or less to allow an interior mounting and a multi-layering of low resistance conductors such as Cu, Ag, or the like by simultaneous baking, and has a low dielectric loss  $\tan\delta$  (a high Q value), a small absolute value of the temperature coefficient of the resonance frequency  $\tau_f$ , and a specific dielectric constant  $\epsilon_r$  of about 8-30 so as to be able to form a suitable size of integrated ceramic parts.

SOLUTION: The dielectric porcelain composition is characterized in that it contains not less than 5 pts.wt. and not more than 150 pts.wt. of a glass component against 100 pts.wt. of a main component represented by general formula:  $x\text{Zn}_2\text{TiO}_4 \cdot (1-x)\text{ZnTiO}_3 \cdot y\text{TiO}_2$ , wherein x is in the range of  $0 < x < 1$  and y is in the range of  $0 < y \leq 0.5$ .

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-221274

(P2003-221274A)

(43) 公開日 平成15年8月5日 (2003.8.5)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テラード (参考)
C 0 4 B 35/46		C 0 4 B 35/46	C 4 G 0 3 0
35/495		H 0 1 B 3/12	3 0 4 4 G 0 3 1
H 0 1 B 3/12	3 0 4	H 0 1 G 4/12	3 5 8 5 E 0 0 1
H 0 1 G 4/12	3 5 8		3 6 1 5 G 3 0 3
	3 6 1	C 0 4 B 35/00	J
		審査請求 未請求 請求項の数 5	O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2002-110518(P2002-110518)

(22) 出願日 平成14年4月12日 (2002.4.12)

(31) 優先権主張番号 特願2001-355697 (P2001-355697)

(32) 優先日 平成13年11月21日 (2001.11.21)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 397047279

宇部エレクトロニクス株式会社

山口県美祿市大嶺町奥分字麦川2023番地2

(71) 出願人

000000206

宇部興産株式会社

山口県宇部市大字小串1978番地の96

(72) 発明者

河野 孝史

山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部

興産株式会社宇部研究所内

(74) 代理人

100092820

弁理士 伊丹 勝

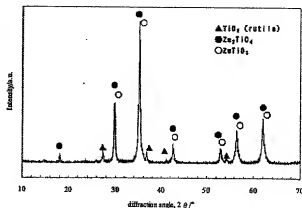
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 誘電体磁器組成物およびこれを用いた積層セラミック部品

(57) 【要約】

【課題】 Cu、Agなどの低抵抗導体の同時焼成による内装化、多層化ができる800～1000℃以下の温度で焼成可能で、かつ、低い誘電損失  $\tan \delta$  (高いQ値) を有し、共振周波数の温度係数  $\tau_f$  の絶対値が小さくかつ積層セラミック部品等を適度な大きさに形成できるように比誘電率  $\epsilon_r$  が8から30程度の誘電体磁器組成物を提供する。

【解決手段】 一般式  $xZn_2TiO_4 - (1-x)ZnTiO_3 - yTiO_2$  で表され、 $x$  が  $0 < x < 1$ 、 $y$  が  $0 < y \leq 0.5$  の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下含有する誘電体磁器組成物に関する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式  $x\text{Zn}_2\text{TiO}_4 - (1-x)\text{ZnTiO}_3 - y\text{TiO}_2$  で表され、 $x$ が $0 < x < 1$ 、 $y$ が $0 < y \leq 0.5$ の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下含有することを特徴とする誘電体磁器組成物。

【請求項2】 前記ガラス成分が、PbO系ガラス、ZnO系ガラス、 $\text{SiO}_2$ 系ガラス、およびPbO、ZnO、 $\text{Bi}_2\text{O}_3$ 、BaO、 $\text{B}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 、ZrO<sub>2</sub>、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、CaO、SrOの群から選択される2種以上の金属酸化物からなるガラスから選択される少なくとも一種であることを特徴とする請求項1記載の誘電体磁器組成物。

【請求項3】 前記主成分100重量部に対して、CuOを40重量部以下含有することを特徴とする請求項1又は2記載の誘電体磁器組成物。

【請求項4】 前記主成分100重量部に対して、MnOを30重量部以下含有することを特徴とする請求項1又は2記載の誘電体磁器組成物。

【請求項5】 複数の誘電体層と、該誘電体層間に形成された内部電極と、該内部電極に電気的に接続された外部電極とを備える積層セラミック部品において、前記誘電体層が前記請求項1ないし4記載の誘電体磁器組成物を焼成して得られる誘電体磁器にて構成され、前記内部電極がCu単体若しくはAg単体、又はCu若しくはAgを主成分とする合金材料にて形成されていることを特徴とする積層セラミック部品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、低抵抗誘導体であるAu、AgやCu等と同時焼成が可能で、積層セラミック部品に好適な低い誘電損失（高いQ値）を有する誘電体磁器組成物、およびそれをを用いた積層セラミックコンデンサやLCフィルタ等の積層セラミック部品に関するものである。特に、 $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$ 、 $\text{ZnTiO}_3$ 、 $\text{TiO}_2$ 及びガラス成分からなる誘電体磁器組成物とそれを用いた積層セラミック部品に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、マイクロ波回路の集積化に伴い、小型でかつ誘電損失（ $\tan \delta$ ）が小さく誘電特性が安定した誘電体共振器が求められている。このような誘電体共振器に使用される誘電体磁器組成物には、比誘電率 $\epsilon_r$ が比較的大きいこと、無負荷Q値が大ききこと、共振周波数の温度係数 $\tau_f$ が小さいことなどが要求されている。一般に、比誘電率 $\epsilon_r$ は大きいほど共振器を小さくできるが、共振周波数が高くなるほど共振器も小さくなる。しかしながら共振器が小さくなりすぎると加工精度が低下し、かつ電極の印刷精度の影響を受けやすくなるため、用途等によって共振器が小さくなりすぎないよ

本発明は、比誘電率 $\epsilon_r$ が8から30程度の誘電体磁器組成物に関するものである。

【0003】 この種の誘電体磁器組成物として、BaO-MgO-WO<sub>3</sub>系材料（特開平6-236708号公報）、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{TiO}_2$ - $\text{Ta}_2\text{O}_5$ 系材料（特開平9-52760号公報）などが提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 最近、誘電体磁器組成物を積層した積層セラミックコンデンサやLCフィルタ等の積層セラミック部品が開発されており、誘電体磁器組成物と内部電極との同時焼成による積層化が行われている。しかしながら、前記誘電体磁器組成物は焼成温度が1300～1400℃と高いため内部電極との同時焼成を行うことは困難な面があり、積層化構造とするためには電極材料として高温に耐えるパラジウム（Pd）や白金（Pt）等の材料に限定されていた。このため、電極材料として低抵抗誘導体でかつ安価な銀（Ag）、Ag-Pd、およびCu等を使用して、1000℃以下の低温で同時焼成可能な誘電体磁器組成物が求められている。

【0005】 本発明の目的は、Cu、Agといった低抵抗誘導体の同時焼成による内装化、多層化ができる800～1000℃以下の温度で焼成可能で、かつ、低い誘電損失 $\tan \delta$ （高いQ値）を有し、共振周波数の温度係数 $\tau_f$ の絶対値が小さくかつ積層セラミック部品等を適度な大きさに形成できるように比誘電率 $\epsilon_r$ が8から30程度の誘電体磁器組成物を提供することにある。また、このような誘電体磁器組成物からなる誘電体層とCuまたはAgを主成分とする内部電極とを有する積層セラミックコンデンサやLCフィルタ等の積層セラミック部品を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明者等は、従来の誘電体磁器材料における上記課題を解決するために鋭意検討した結果、下記の組成ものがこの要求を満足するものであることを見出した。

【0007】 本発明は、一般式  $x\text{Zn}_2\text{TiO}_4 - (1-x)\text{ZnTiO}_3 - y\text{TiO}_2$  で表され、 $x$ が $0 < x < 1$ 、 $y$ が $0 < y \leq 0.5$ の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下含有することを特徴とする誘電体磁器組成物に関する。

【0008】 前記ガラス成分としては、PbO系ガラス、ZnO系ガラス、 $\text{SiO}_2$ 系ガラスあるいはPbO、ZnO、 $\text{Bi}_2\text{O}_3$ 、BaO、 $\text{B}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SiO}_2$ 、ZrO<sub>2</sub>、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、CaO、SrOの群から選択された2種以上の金属酸化物からなるガラスであることが好ましい。

【0009】 さらに、本発明は前記主成分100重量部

体磁器組成物に関する。

【0010】また、本発明は前記主成分100重量部に対して、 $MnO$ を30重量部以下含有する前記の誘電体磁器組成物に関する。

【0011】また、本発明は、複数の誘電体層と、該誘電体層間に形成された内部電極と、該内部電極に電気的に接続された外部電極とを備える積層セラミック部品において、前記誘電体層が前記誘電体磁器組成物を焼成して得られる誘電体磁器にて構成され、前記内部電極がCu単体若しくはAg単体、又はCu若しくはAgを主成分とする合金材料にて形成されていることを特徴とする積層セラミック部品に関する。

【0012】 $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ 、 $TiO_2$ およびガラス成分からなる特定の組成とすることにより、1000℃以下の焼成温度で、比誘電率 $\epsilon_r$ が8〜30程度で、誘電損失が小さく、共振周波数の温度係数の絶対値が60ppm/℃以下とすることができる。また、CuO又は $MnO$ を副成分として添加することにより、さらに焼成温度を低下させることができる。これにより、Cu若しくはAg単体、又はCu若しくはAgを主成分とする内部電極を有する積層セラミック部品を提供することができる。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明の誘電体磁器組成物について具体的に説明する。本発明の誘電体磁器組成物は、一般式 $xZn_2TiO_4 - (1-x)ZnTiO_3 - yTiO_2$ で表され、 $x > 0$ 、 $x < 1$ 、 $y > 0$ 、 $y \leq 0.5$ の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下含有することを特徴とする。

【0014】前記組成において $y > 0.5$ より大きいと、 $\tau_f$ が+60ppm/℃以上になり好ましくない。また、本発明の誘電体磁器組成物は、セラミックス母材となる前記主成分100重量部に対してガラス成分が5重量部未満では焼成温度が高くなり、150重量部を超える場合にはガラスが溶出してセッターと反応する傾向にある。

【0015】また、本発明に用いる $Zn_2TiO_4$ は酸化亜鉛 $ZnO$ と酸化チタン $TiO_2$ とをモル比2:1で混合し焼成することにより得ることができる。また、 $ZnTiO_3$ は $ZnO$ と $TiO_2$ とをモル比1:1で混合し焼成することにより得ることができる。 $Zn_2TiO_4$ および $ZnTiO_3$ の原料として、 $TiO_2$ と $ZnO$ の他に、焼成時に酸化物となる硝酸塩、炭酸塩、水酸化物、塩化物、および有機金属化合物等を使用してもよい。

【0016】本発明の誘電体磁器組成物では、ガラスを所定量含有することを特徴とする。ここで、ガラスとは非結晶質の固体物質で、熔融により得られたものをい

すもガラスに含まれる。固体物質としては、酸化物から成る無機物質があげられ、本発明に用いるガラスとしては、 $PbO$ 系ガラス、 $ZnO$ 系ガラス、 $SiO_2$ 系ガラス、その他金属酸化物からなるガラスが挙げられる。 $PbO$ 系ガラスは、 $PbO$ を含有するガラスであり、 $PbO-SiO_2$ 、 $PbO-B_2O_3$ 、 $PbO-P_2O_5$ を含有するガラスや、 $R_2O-PbO-SiO_2$ 、 $R_2O-CaO-PbO-SiO_2$ 、 $R_2O-ZnO-PbO-SiO_2$ 、 $R_2O-Al_2O_3-PbO-SiO_2$ を含有するガラス（但しここで $R$ は $Na_2O$ 、 $K_2O$ ）などが例示される。 $ZnO$ 系ガラスは、 $ZnO$ を含有するガラスであり、 $ZnO-Al_2O_3-BaO-SiO_2$ 、 $ZnO-Al_2O_3-R_2O-SiO_2$ 、などが例示される。 $SiO_2$ 系ガラスは、 $SiO_2$ を含有するガラスであり、 $SiO_2-Al_2O_3-R_2O$ 、 $SiO_2-Al_2O_3-BaO$ 、などが例示される。

【0017】さらに、本発明に用いるガラスとしては、 $PbO$ 系ガラス、 $ZnO$ 系ガラス、 $SiO_2$ 系ガラスの他にも、各種金属酸化物からなるガラスも使用することができ、 $PbO$ 、 $ZnO$ 、 $B_2O_3$ 、 $BaO$ 、 $B_2O_3$ 、 $SiO_2$ 、 $ZrO_2$ 、 $TiO_2$ 、 $Al_2O_3$ 、 $CaO$ 、 $SrO$ の群から選択された2種以上の金属酸化物からなるガラスも用いられる。ガラスは非晶質ガラスや結晶質ガラスのどちらを用いてもよい。 $PbO$ を含有すると焼成温度は低下する傾向にあるが、無負荷 $Q$ 値が低下する傾向にあり、ガラス中の $PbO$ 成分の含有量は、40重量%以下が好ましい。また、ガラス中に $SiO_2$ と $Al_2O_3$ 成分を同時に含むガラス（即ち、 $SiO_2-Al_2O_3$ 系ガラス）は、本発明に用いるガラスとして特に好適である。特に本発明では、 $ZnO-Al_2O_3-BaO-SiO_2$ が、高い無負荷 $Q$ 値を得ることができる点から好ましい。

【0018】本発明によれば、一般式 $xZn_2TiO_4 - (1-x)ZnTiO_3 - yTiO_2$ で表され、 $x > 0$ 、 $x < 1$ 、 $y > 0$ 、 $y \leq 0.5$ の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下含有させることにより、800〜1000℃の焼成温度で低温焼結可能で、かつ比誘電率 $\epsilon_r$ が8〜30程度で、無負荷 $Q$ 値が大きく、共振周波数の温度係数 $\tau_f$ が±60ppm/℃以内という特性を有する誘電体磁器組成物を得ることができる。

【0019】本発明では、焼成前に $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ およびガラス粒子は、個別に粉砕し混合されるか、あるいは、各原料粒子は混合された状態で粉砕されるが、焼成前のこれら原料粒子の平均粒子径は5 $\mu m$ 未満、好ましくは1 $\mu m$ 以下であることにより、さらに低温焼成が可能となる。なお、平均粒子径を過度に小さくすると取り扱いが困難になる場合があるので、0.05 $\mu m$ 以上とするのが好ましい。

物にさらに副成分としてCuOを含有させ、一般式 $xZn_2TiO_4 - (1-x)ZnTiO_3 - yTiO_2$ で表され、 $x$ が $0 < x < 1$ 、 $y$ が $0 < y \leq 0.5$ の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下、CuOを40重量部含有する誘電体磁器組成物とすることにより、前記の各種特性を劣化させることなく、さらに焼成温度を下げることができる。CuOが主成分100重量部に対して40重量部を越える場合は、 $\tau_f$ が60ppm/°Cより小さくなり好ましくない。

【0021】また、本発明では、同じく前記の誘電体磁器組成物に副成分としてMnOを含有させ、一般式 $xZn_2TiO_4 - (1-x)ZnTiO_3 - yTiO_2$ で表され、 $x$ が $0 < x < 1$ 、 $y$ が $0 < y \leq 0.5$ の範囲内である主成分100重量部に対して、ガラス成分を5重量部以上150重量部以下、MnOを30重量部含有する誘電体磁器組成物とすることによっても、前記の各種特性を劣化させることなく、同様に焼成温度を下げるができる。MnOが主成分100重量部に対して30重量部を越える場合は、Q値が低下するため好ましくない。

【0022】副成分として添加するCuO又はMnOは単独で添加してもよいし、両成分を一緒に添加してもよい。

【0023】次に、本発明の誘電体磁器組成物の製造方法について説明する。まず、酸化チタンと酸化亜鉛を2:1の比率に秤量し、水、アルコール等の溶媒と共に湿式混合する。続いて、水、アルコール等を除去した後、粉碎し、酸素含有雰囲気（例えば空気雰囲気）下にで900~1200°Cで約1~5時間程度仮焼成する。このようにして得られた仮焼粉は $Zn_2TiO_4$ である。次に酸化チタンと酸化亜鉛を1:1の比率に秤量し、 $Zn_2TiO_4$ と同様な作製方法で $ZnTiO_3$ を作製した。これら $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ 、 $TiO_2$ とガラス、及び必要に応じてCuO又はMnOを所定の比率に秤量し、水、アルコール等の溶媒と共に湿式混合する。続いて、水、アルコール等を除去した後、粉碎して原料粉末を作製する。

【0024】本発明の誘電体磁器組成物の誘電特性はベレットの形状で評価する。詳しくは、前記原料粉末にポリビニルアルコールの如き有機バインダーを混合して均質にし、乾燥、粉碎をおこなった後、ベレット形状に加圧成形（圧力100~1000Kg/cm<sup>2</sup>程度）する。得られた成形物を空気の如き酸素含有ガス雰囲気下にて800~1000°Cで焼成することにより、 $Zn_2TiO_4$ 相、 $ZnTiO_3$ 相、 $TiO_2$ 相およびガラス相が共存する誘電体磁器組成物を得ることができる。

【0025】こうして得られた誘電体磁器組成物も、必要により適当な形状、およびサイズに加工し、あるいは下

電極による積層化を行うことにより、各種積層セラミック部品の材料として利用できる。積層セラミック部品としては、積層セラミックコンデンサ、LCフィルタ、誘電体共振器、誘電体基板などが挙げられる。

【0026】本発明の積層セラミック部品は、複数の誘電体層と、該誘電体層間に形成された内部電極と、該内部電極に電気的に接続された外部電極とを備えており、前記誘電体層が前記誘電体磁器組成物を焼成して得られる誘電体磁器にて構成され、前記内部電極がCu単体若しくはAg単体、又はCu若しくはAgを主成分とする合金材料にて形成されている。本発明の積層セラミック部品は、誘電体磁器組成物を含有する誘電体層と、Cu単体若しくはAg単体、又はCu若しくはAgを主成分とする合金材料とを、同時焼成することにより得られる。

【0027】上記積層セラミック部品の1実施形態として、例えば図1に示したトリプレートタイプの共振器が挙げられる。図1は、本発明に係る1実施形態のトリプレートタイプの共振器を示す斜視図である。図1に示すように、トリプレートタイプの共振器は、複数の誘電体層と、該誘電体層間に形成された内部電極2と、該内部電極に電気的に接続された外部電極3とを備える積層セラミック部品である。トリプレートタイプの共振器は、内部電極2を中央部に配置して複数枚の誘電体セラミック層1を積層して得られる。内部電極2は、図1に示した第1の面Aからこれに対向する第2の面Bまで貫通するように形成されており、第1の面Aのみ開放面であり、第1の面Aを除く共振器の上面には外部電極3が形成されており、第2の面Bにおいて内部電極2と外部電極3が接続されている。内部電極2の材料は、CuまたはAgあるいは、それらを主成分として構成されている。本発明の誘電体磁器組成物では低温で焼成できるため、これらの内部電極の材料が使用できる。

【0028】

#### 【実施例】実施例1

酸化チタン( $TiO_2$ ) 0.33モル、酸化亜鉛( $ZnO$ ) 0.66モルをエタノールと共にボールミルに入れ、12時間湿式混合した。溶液を脱媒後、粉碎し、空気雰囲気下1000°Cで仮焼成し、 $Zn_2TiO_4$ 仮焼粉を得た。次に $TiO_2$  0.5モル、 $ZnO$  0.5モルを同様な方法で湿式混合・仮焼成して $ZnTiO_3$ 仮焼粉を得た。これら $Zn_2TiO_4$ 仮焼粉、 $ZnTiO_3$ 仮焼粉と $TiO_2$ を表1に示した配合量で調整したものを母材とした。この母材と母材100重量部に対して $ZnO$  52重量%、 $SiO_2$  6重量%、 $Al_2O_3$  12重量%、 $B_2O_3$  30重量%から構成されるガラス粉末10重量部を添加したものをボールミルに入れ、24時間湿式混合した。溶液を脱媒後、平均粒子径が1 $\mu m$ になるまで粉碎し、この粉碎物に適量のポリビ

み4mmのペレットに成形し、空気雰囲気下において、900℃で2時間焼成した。図2に作製した焼結体のX線回折図を示した。図2に示したように本発明の誘電体磁器組成物の焼結体においても $Zn_2TiO_4$ 相、 $ZnTiO_3$ 相および $TiO_2$ 相が共存していることがわかる。

【0029】こうして得られた誘電体磁器組成物を直径

7mm、厚み3mmの大きさに加工した後、誘電共振法によって、共振周波数7~11GHzにおける無負荷Q値、比誘電率 $\epsilon_r$ および共振周波数の温度係数 $\tau_f$ を求めた。その結果を表2に示した。

【0030】

【表1】



	$\epsilon_r$	$Q \times f$	$\tau_f$ (ppm/°C)	焼成温度 (°C)
実施例	1	20	10000	0
	2	15	9000	-20
	3	12	8000	-30
	4	10	6000	-30
	5	19	9000	-10
	6	24	10000	55
	7	17	15000	-15
	8	20	12000	0
	9	22	12000	60
	10	24	10000	48
	11	15	14700	4
	12	15	16500	12
	13	13	2000	-80
	14	16	15000	14
	15	18	8000	-80
	16	21	11000	0
	17	21	11500	0
	18	20	9000	6
	19	22	6000	15
	20	16	3000	-40
	21	20	9000	0
	22	18	9000	-30
	23	16	7000	-40
	24	20	9000	-30
	25	22	6000	-8
比較例	1	1000°C以下では未焼結		
	2	1000°C以下では未焼結		
	3	1000°C以下では未焼結		
	4	ガラスが溶出		
	5	30	10000	80

【0032】また前記母材とガラスの混合物100gに対して、結合剤としてポリビニルピチラール9g、可塑剤としてジブチルフタレート6gおよび溶剤としてトルエン60gとイソプロピルアルコール30gを添加しドクターブレード法により厚さ100 $\mu$ mのグリーンシートを作製した。そして、このグリーンシートを、65°Cの温度で200k $\text{g}/\text{cm}^2$ の圧力を加える熱圧着により、22層積層した。その際、内部電極としてA $\text{g}$ を印刷した層が厚み方向の中央部にくるように配置した。得られた積層体を900°Cで2時間焼成した後、外部電極を形成して、トリプレートタイプの共振器を作製した。大きさは、幅4.9mm、高さ1.7mm、長さ8.4mmである。

【0033】得られたトリプレートタイプの共振器について共振周波数2GHzで無負荷Q値を評価した。その結果、焼成温度は900°Cで、取組率は19%、比誘電率 $\epsilon_r$ は21、共振周波数の温度係数 $\tau_f$ は0ppm/°Cで無負荷Qは210であった。このように、本発明に係る誘電体磁器組成物を使用することにより、優れた特性を有するトリプレートタイプの共振器が得られた。

【0034】実施例2～4  
上記実施例1と同様に $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$ 、 $\text{ZnTiO}_3$ と $\text{TiO}_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材とガラスを表1に示した配合量で混合後、実施例1と同一条件でベレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。

【0035】実施例5～10

$\text{TiO}_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材とガラスを表1に示した配合量で混合後、実施例1と同一条件でベレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。

【0036】実施例11～15

上記実施例1と同様に $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$ 、 $\text{ZnTiO}_3$ と $\text{TiO}_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材と表1記載の種々のガラスを表1に示した配合量で混合後、実施例1と同一条件でベレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。

【0037】実施例16、17

上記実施例1と同様に $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$ 、 $\text{ZnTiO}_3$ と $\text{TiO}_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材と表1記載の種々のガラスを表1に示した配合量で混合後、粒子径が表1記載の平均粒子径になるまで粉砕し、実施例1と同一条件でベレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。

【0038】実施例18～20

上記実施例1と同様に $\text{Zn}_2\text{TiO}_4$ 、 $\text{ZnTiO}_3$ と $\text{TiO}_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材と表1記載の種々のガラス及び $\text{MnO}$ を表1に示した配合量で混合後、粒子径が表1記載の平均粒子径になるまで粉砕し、実施例1と同一条件でベレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。



上記実施例1と同様に $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ と $TiO_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材と表1記載の種々のガラス及びCuOを表1に示した配合量で混合後、粒子径が表1記載の平均粒子径になるまで粉碎し、実施例1と同一条件でペレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。

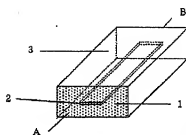
#### 【0040】実施例24、25

上記実施例1と同様に $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ と $TiO_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材と表1記載の種々のガラス及びMnOとCuOとを表1に示した配合量で混合後、粒子径が表1記載の平均粒子径になるまで粉碎し、実施例1と同一条件でペレット形状の焼結体を作製して、実施例1と同様な方法で種々の特性を評価した。その結果を表2に示した。

#### 【0041】比較例1～4

上記実施例1と同様に $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ と $TiO_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この表1記載のガラスを表1に示した配合量で混合後、実施例1と同一条件でペレット形状の焼結体を作製した。しかしながらガラスの添加量が母材100重量部に対して5重量部未満の条件では1000℃以下では焼結できず1200℃まで高めないと緻密化することができなかった。また150重量部を超えた場合にはガラスが溶出してセッターと反応し、良好な焼結体は得られなかった。その結果を表2に示した。

【図1】



#### 【0042】比較例5

上記実施例1と同様に $Zn_2TiO_4$ 、 $ZnTiO_3$ と $TiO_2$ を表1に示した配合量で混合したものを母材とし、この母材とガラスを表1に示した配合量で混合後、実施例1と同一条件でペレット形状の焼結体を作製した。しかしながら $TiO_2$ のモル比 $\gamma$ が0.6の条件では共振周波数の温度係数 $\tau_f$ が+60ppm/℃以上となった。その結果を表2に示した。

#### 【0043】

【発明の効果】本発明の誘電体磁器組成物によれば、比誘電率 $\epsilon_r$ が8から30で、かつ無負荷Q値が大きく、しかも共振周波数の温度係数 $\tau_f$ が±60ppm/℃以内と小さい誘電体磁器組成物を提供することができる。また1000℃以下の温度で焼成できるため、焼成に要する電力費が低減されるとともに、Cu単体若しくはAg単体、又はCu若しくはAgを主成分とする合金材料からなる低抵抗導体と同時に焼成可能であり、さらにこれを内部電極とした積層部品を提供できる。

#### 【図面の簡単な説明】

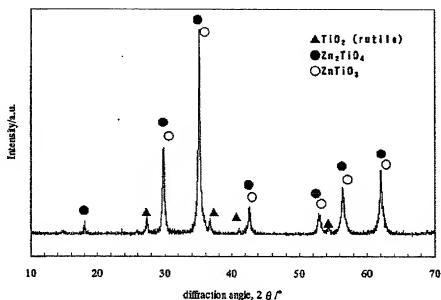
【図1】本発明に係る積層セラミック部品の1実施形態の説明図である。

【図2】実施例1で得られた本発明にかかる誘電体磁器組成物の焼結体のX線回折図である。

#### 【符号の説明】

- 1 誘電体セラミック層
- 2 内部電極
- 3 外部電極

【図2】



フロントページの読み

(72)発明者 福田 晃一

山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部  
興産株式会社宇部研究所内

F ターム(参考) 4G030 AA08 AA09 AA10 AA16 AA17  
AA25 AA31 AA32 AA35 AA36  
AA37 AA40 AA43 BA09  
4G031 AA04 AA05 AA06 AA11 AA12  
AA19 AA25 AA26 AA28 AA29  
AA30 AA32 BA09  
5E001 AB03 AE01 AE02 AE03 AF06  
AH01 AH05 AH09 AJ01 AJ02  
5G303 AA01 AA04 AB07 AB08 BA12  
CA03 CB01 CB02 CB03 CB05  
CB06 CB11 CB18 CB25 CB30  
CB32 CB35 CB38 CB39